

熱 CVD 装置

■ 用途

最高 900℃の加熱制御が行えるホットウォール式の熱 CVD 装置です。

化合物半導体のエピタキシャル成長など、先端技術デバイスの研究・開発に活躍しています。

直感的に操作が行える手動装置の為、簡易的な実験を行う研究室、教育機関に適しています。

【導入分野】 研究開発、試作品開発



■ 特徴

石英管やアルミナ管を処理炉として構成したバッチ式管状炉です。

炉外径φ100 mm、最高 900℃を標準とし、ヒータ中央から±200 mmの範囲で加熱制御します。

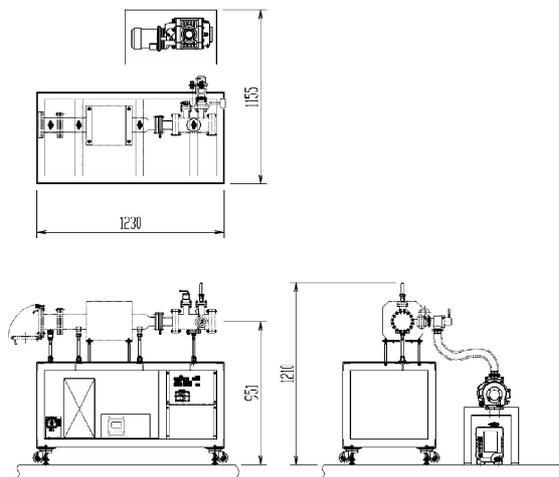
オプションでテトラエトキシシラン(TEOS)などの供給設備を備えることが可能です。

お客様の御要望に沿って、さまざまな成膜環境のご相談にお応えしています。

■ 仕様

熱 CVD 装置

排気性能	到達圧力	≦ 0.13 Pa	制御系	主操作	手動 制御盤 各種操作パネル
	排気時間	≦ 0.13 Pa 1 min 以内		プロセスガス	TEOS ガス供給
真空槽	真空槽	透明石英管 / φ 100 mm (最大外径) アルミナ管 / φ 100 mm (最大外径)	オプション	水冷機構	冷却水循環装置
排気系	主排気ポンプ	油回転真空ポンプ		排気バルブ	自動バルブ
	補助ポンプ	メカニカルブースタポンプ	ユーティリティ	電力・接地	主電源系 3φ AC200V 60A 50/60 Hz
	各種バルブ	手動操作		冷却水	供給圧 : 0.2 ~ 0.3 MPa 水温 : 20 ~ 35 °C 水量 : ≧ 10 L/min
真空計	低真空	ピラニ真空計		ベントガス	窒素ガス 0.1 ~ 0.15 MPa
基板	基板サイズ	MAX φ40 mm 不定形状 可能		圧縮空気	0.5 ~ 0.8 MPa
槽内アクセス	アクセスドア	Oリングシール		設置面積	(W×D×H) =1300mm×1300mm×1500mm
機能	加熱温度	常用 800 °C MAX 900 °C			
	加熱域	2 ゾーン			
	ヒータ容量	2 kW			



■ 株式会社 日本シード研究所

本社・工場： 〒252-1125
神奈川県綾瀬市吉岡東 2-3-27

電話： 0467-77-4351

FAX： 0467-77-9858

URL： <https://www.seed-lab.com>

※外観・仕様については改善のため予告なく変更することがあります。
2024.11